

Содержание

● Атомная структура и неэлектронные свойства полупроводников

Безъязычная Т.В., Зеленковский В.М., Гурский А.Л., Рябцев Г.И.

Структурные и энергетические характеристики собственных дефектов вакансионного типа в дуосо-напряженной решетке GaN 1281

Сибирёв Н.В., Дубровский В.Г., Цырлин Г.Э., Егоров В.А., Самсоненко Ю.Б., Устинов В.М.

О зависимости высоты нитевидных нанокристаллов GaAs от скорости осаждения 1286

● Электронные и оптические свойства полупроводников

Клевков Ю.В., Колосов С.А., Кривобок В.С., Мартовицкий В.П., Николаев С.Н.

Электрические свойства, фотопроводимость и фотолюминесценция крупнозернистого p -ZnTe 1291

Алиев Ф.Ф., Джафаров М.Б.

Энергетический спектр носителей заряда в Ag_2Te 1297

Вейнгер А.И., Забродский А.Г., Тиснек Т.В., Голощапов С.И.

Электронный парамагнитный резонанс взаимодействующих спинов в n -Ge II. Изменение ширины и формы линий 1301

Беляев А.П., Рубец В.П., Антипов В.В., Гришин В.В.

Электрические и гальваномагнитные свойства пленок теллурида кадмия, синтезированных в резко неравновесных условиях 1309

● Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность

Парфенюк О.А., Илащук М.И., Ульяницкий К.С.

Образование омических контактов к низкоомному $Cd_{1-x}Mg_xTe$ для фотовольтаических применений 1314

Давыдов С.Ю., Трошин А.В.

Роль спонтанной поляризации в формировании структур $NH-SiC/3C-SiC/NH-SiC$ на основе политипов карбида кремния 1318

Ковалюк З.Д., Политанская О.А., Сидор О.Н., Маслюк В.Т.

Электрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12.5 МэВ 1321

Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Варавин В.С., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н., Сидоров Ю.Г., Васильев В.В.

Свойства МДП структур на основе варизонного HgCdTe, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии . 1327

Сутурин С.М., Банщиков А.Г., Соколов Н.С., Тягинов С.Э., Векслер М.И.

Статические вольт-амперные характеристики туннельных МДП структур Au/CaF₂/n-Si(111) 1333

Шашкин В.И., Востоков Н.В.

Решение задачи инжекции носителей тока в изолирующий слой при самосогласованных граничных условиях на контактах 1339

Бессолов В.Н., Бланк Т.В., Гольдберг Ю.А., Константинов О.В., Поссе Е.А.

Зависимость механизма протекания тока в сплавном омическом контакте In- n -GaN от концентрации основных носителей заряда 1345

● Низкоразмерные системы

Решина И.И., Иванов С.В.

Магнитооптика одиночной квантовой ямы CdMnSe/CdMgSe 1348

● Аморфные, стеклообразные, пористые, органические, микрокристаллические полупроводники, полупроводниковые композиты

Бордовский Г.А., Марченко А.В., Теруков Е.И., Серегин П.П., Лиходеева Т.В.

Свойства и структура стекол $(As_2Se_3)_{1-z}(SnSe_2)_{z-x}(Te_2Se)_x$ и $(As_2Se_3)_{1-z}(SnSe)_z-x(Te_2Se)_x$ 1353

Ундалов Ю.К., Теруков Е.И., Гусев О.Б., Лебедев В.М., И.Н. Трапезникова

Влияние электрического поля при получении пленок $\alpha-SiO_x:H(Er,O)$ методом магнетронного распыления на постоянном токе на их состав и интенсивность фотолюминесценции ионов эрбия 1357

Андреев А.А.

Особенности световых вольт-амперных характеристик $p-i-n$ структур на аморфном кремнии при туннельно-дрейфовом механизме переноса темнового тока 1363

Александрова Е.Л., Иванов А.Г., Геллер Н.М., Надеждина Л.Б., Шаманин В.В.

Светочувствительные свойства металлосодержащих полидисалицилиденазометинов 1367

● Физика полупроводниковых приборов

Леликов Ю.С., Бочкарева Н.И., Горбунов Р.И., Мартынов И.А., Ребане Ю.Т., Тархин Д.В., Шретер Ю.Г.

Измерение коэффициента поглощения света, распространяющегося латерально в светодиодных структурах с квантовыми ямами $In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN$ 1371

Емельянов А.М.

Краевая электролюминесценция эффективного точечного кремниевого светодиода в области температур 80–300 К 1375

Боброва Е.А., Омельяновская Н.М.

Особенности вольт-фарадных характеристик МОП структур, обусловленные зарядом в окисле 1380

Бочкарева Н.И., Горбунов Р.И., Клочков А.В., Леликов Ю.С., Мартынов И.А., Ребане Ю.Т., Белов А.С., Шретер Ю.Г.

Оптические свойства голубых светодиодов в системе InGaN/GaN при высокой плотности тока 1384

Кашерининов П.Г., Томасов А.А.

Быстрые оптические регистрирующие среды на полупроводниковых наноструктурах для записи и обработки изображений 1391

● Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Александров О.В., Дусь А.И.

Модель термического окисления кремния на фронте объемной реакции 1400